



济南市半导体元件实验所

# 肖特基二极管系列产品

## 2DK120 型硅肖特基高速二极管

### 1 特性

芯片采用硅外延平面结构，器件有 D2-03A 型玻璃封装。

具有正向压降低、正向导通损耗小，体积小、重量轻，可靠性高的特点。

器件的静电放电敏感度为 4000V，D2-03A 典型重量 200mg。



D2-03A

### 2 质量等级及执行标准

G 级：QZJ840611；

JCT 级：ZZR-Q/RBJ20044-2006。

### 3 最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型号	$I_{FM}$ mA	$V_{RM}$ V	$V_{RWM}$ V	$I_{FSM}$ $t_p=8.3\text{ms}, T_A=25^\circ\text{C}$ mA	$T_j$ °C	$T_{stg}$ °C
2DK120	1000	30	24	6000	-55~150	-55~150

### 4 主要电特性

主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ ）见表 2。

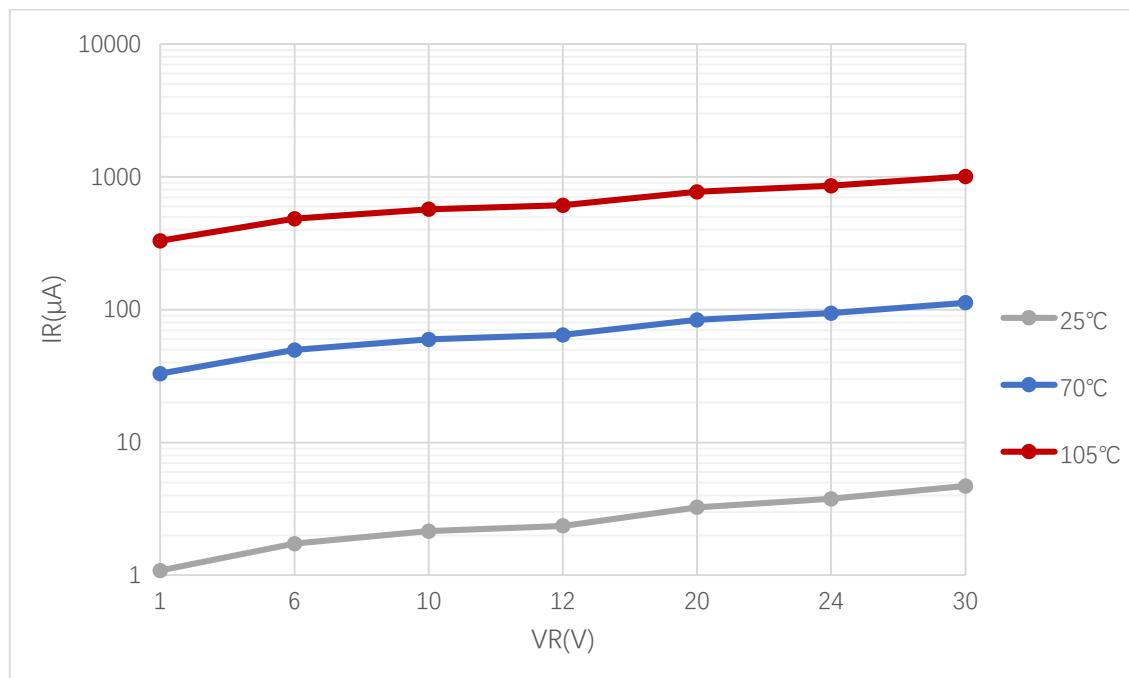
表 2 主要电特性

序号	符号	测试条件	规范值
1	正向压降 $V_{F1}$	$I_F=1000\text{mA}$	$\leq 0.60\text{V}$
2	正向压降 $V_{F2}$	$T_A=-55^\circ\text{C}, I_F=1000\text{mA}$	$\leq 1.8\text{V}$
3	反向电流 $I_{R1}$	$V_R=10\text{V}$	$\leq 5\mu\text{A}$
4	反向电流 $I_{R2}$	$T_A=105^\circ\text{C}, V_R=10\text{V}$	$\leq 2\text{mA}$

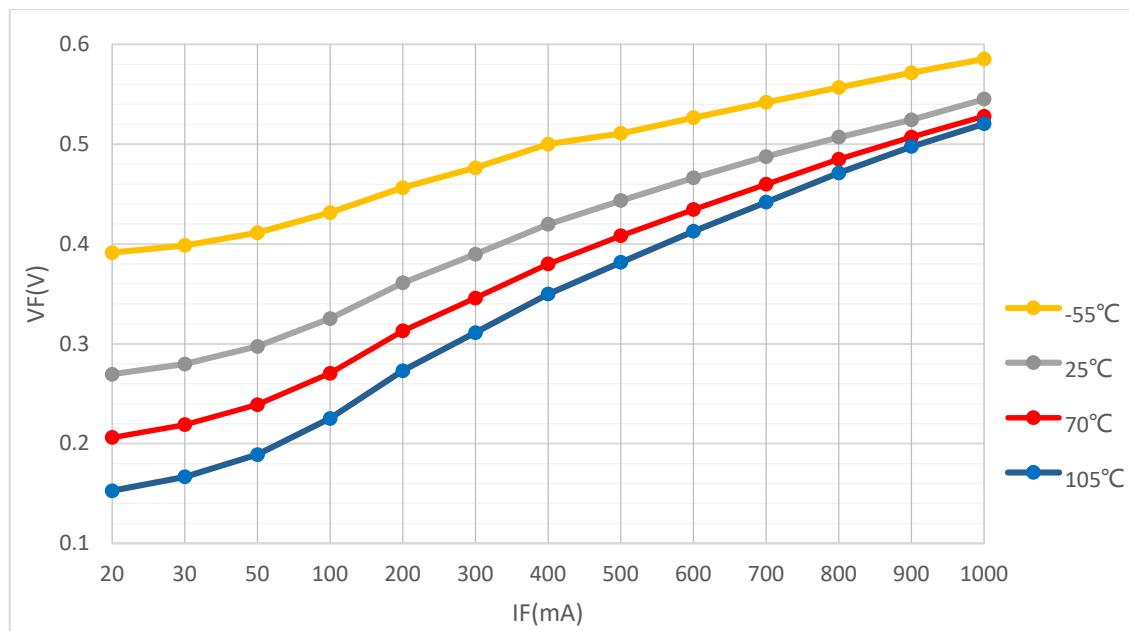


## 5 特性曲线

### 5.1 不同温度、不同电压下的反向电流曲线

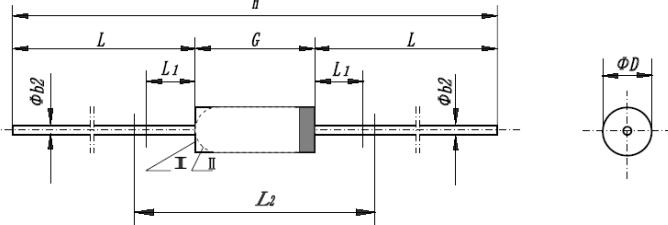
图 1  $I_R - V_R$  特性曲线

### 5.2 不同温度、不同电流下的正向电压曲线

图 2  $V_F - I_F$  特性曲线



## 6 外观尺寸



注：①  $L_1$  尺寸指在此段内引线直径不予限制，以允许引线涂料和表面少量的凹凸不平存在。  
②  $L_2$  为引线弯曲成直角后器件安装的最小轴向长度。  
③ 主体形状允许采用两种形式，见图中轮廓线 I 、 II 。

单位为毫米

代号	D2-03A	
符号	最小值	最大值
$\phi b2$	0.458	0.558
$\phi D$	2.16	2.71
$G$	5.85	7.62
$H$	58	—
$L$	26	—
$L1$	—	2.5
$L2$	16	—

图 3 D2-03A 外形尺寸